PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-043167

(43)Date of publication of application: 08.02.2002

(51)Int.CI.

H01G 4/30 H01G 4/224

H01G 4/12 H01L 37/00

(21)Application number : 2000-220694

(71)Applicant: MURATA MFG CO LTD

(22)Date of filing:

21.07.2000

(72)Inventor: KISHIMOTO ATSUSHI

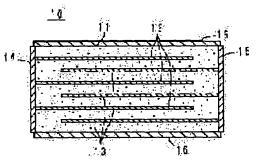
KODAMA MASAHIRO

NIIMI HIDEAKI

(54) CHIP-TYPE ELECTRONIC COMPONENT AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a chip-type electronic component, having a glass coat layer resistant to crackings and a ceramic member whose insulation resistance is hard to degrade, and to provide a method of manufacturing the same. SOLUTION: A laminate capacitor has a laminate 11, made of laminated ceramic green sheets; internal electrodes 12, 13 printed on the green sheet; external electrodes 14, 15 formed at both end portions of the faminate 11; and a glass coat layer for covering the surface of the laminate 11 except for the part, where the external electrodes are formed. In the glass coat layer 16, the atomic ratio of alkaline metal element content to silicon element content is gradually increased from the surface to the inside. This laminate capacitor is formed by coating the laminate 11 with the glass coat layer 16, in which the atomic ratio of alkaline metal content to silicon content is 0.3 or more, and then by dipping the coated laminate 11 in an acidic aqueous solution.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.04.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-43167 (P2002-43167A) (43)公開日 平成14年2月8日(2002.2.8)

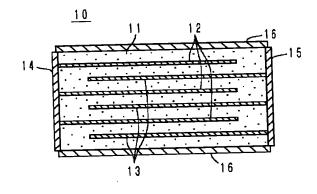
7		## DU ##	FI.		F I			テーマコード(参考)
(51) Int. C1. 7		識別記	万		H01G	4/30	301 J	5E001
H 0 1 G	4/30	3 0 1			11010	1,00		5E082
		3 1 1			· · ·	4/12	3 5 5	
	4/224					4/12	364	
	4/12	3 5 5					445	
		364						最終頁に続く
	審査請求	未請求	請求項の数3	OL			(全4頁) ————	
(21)出願番号	特	顏2000-22	0694 (P2000-220694)		(71)出願人)6231 会社村田製作所	
(22)出願日	平成12年7月21日(2000.7.21)				(72)発明者	岸本	存長岡京市天神二 敦司	二丁目26番10号 二丁目26番10号 株式
						会社	村田製作所内	_] 日20番10万
					(72) 発明者	京都	雅弘 府長岡京市天神』 村田製作所内	二丁目26番10号 株式
					(74)代理力	-	91432 士 森下 武一	
								最終頁に続く

(54) 【発明の名称】チップ型電子部品及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 ガラスコート層のひび割れが発生しにくく、 セラミック素体の絶縁抵抗が劣化しにくいチップ型電子 部品及びその製造方法を提供する。

【解決方法】 セラミックグリーンシートを積層してなる積層体11と、そのグリーンシート上に印刷された内部電極12,13と、該積層体11の両端部に設けた外部電極14,15と、積層体11の外部電極形成面以外の表面を被覆するガラスコート層16からなる積層コンデンサ。ガラスコート層16は、その表面近傍から内部に向かって、ケイ素元素の含有量に対するアルカリ金属元素の含有量に対するアルカリ金属元素の含有量の原子比が暫増している。この積層コンデンサは、積層体11の表面に、ケイ素元素の含有量に対するアルカリ金属元素の含有量の原子比が0.3以上のアルカリ金属を含むガラスコート層16を施した後、酸性水溶液中に浸漬して得る。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 セラミックからなる素体の表面にガラス コート層を施したチップ型電子部品において、

前記ガラスコート層の表面近傍から内部に向かって、ケ イ素元素の含有量に対するアルカリ金属元素の含有量の 原子比が暫増していること、

を特徴とするチップ型電子部品。

【請求項2】 前記素体がセラミックグリーンシートを 積層した積層体からなることを特徴とする請求項1記載 のチップ型電子部品。

【請求項3】 セラミックからなる素体の表面に、ケイ 素元素の含有量に対するアルカリ金属元素の含有量の原 子比が 0. 3以上のアルカリ金属を含むガラスコート層 を施す工程と

前記ガラスコート層を有する素体を酸性水溶液中に浸漬. する工程と、

を備えたこと特徴とするチップ型電子部品の製造方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、チップ型電子部 品、特に、セラミックからなる素体を有するチップ型電 子部品及びその製造方法に関する。

【従来の技術】積層コンデンサをはじめ電子部品の多く がチップ化されている。しかし、それらは、セラミック が表面に露出しているため、耐湿性などの信頼性が低 い。そこで、高い信頼性を得るため、特開平3-250 603号公報には、露出しているセラミック表面をガラ スコート層で被うことが開示されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記セ ラミック製チップ型電子部品では、ガラスコート層にひ び割れが生じたり、セラミック素体の絶縁抵抗の劣化が 生じたりしていた。

【0004】そこで、本発明の目的は、ガラスコート層 のひび割れが発生しにくく、セラミック素体の絶縁抵抗 が劣化しにくいチップ型電子部品及びその製造方法を提 供することにある。

[0005]

するため、本発明に係るチップ型電子部品は、セラミッ クからなる素体の表面にガラスコート層を施したチップ 型電子部品において、前記ガラスコート層の表面近傍か ら内部に向かって、ケイ素元素の含有量に対するアルカ リ金属元素の含有量の原子比が暫増していることを特徴 とする。ここで、表面近傍とは、ガラスコート層におい て、該ガラスコート層の表面からの大気中の水分付着及 び二酸化炭素吸着の影響を受けなくなる境目を意味す

【0006】以上の構成からなるチップ型電子部品にお 50 液(Na/Si=0. 6)に10分間浸漬し、その後、

いては、ガラスコート層の表面近傍から内部に向かっ て、ケイ素元素の含有量に対するアルカリ金属元素の含 有量の原子比が暫増しているため、ガラスコート層のひ び割れが発生しにくく、セラミック素体の絶縁抵抗が劣 化しにくくなる。

【0007】このようなセラミック電子部品は、セラミ ックからなる素体の表面に、ケイ素元素の含有量に対す るアルカリ金属元素の含有量の原子比が0.3以上のア ルカリ金属を含むガラスコート層を施した後、ガラスコ 10 一ト層を有する素体を酸性水溶液中に浸漬することによ り得ることができる。

[0008]

【発明の実施の形態】以下に、本発明に係るチップ型電 子部品及びその製造方法の実施の形態について説明す る。本実施形態ではチップ型電子部品として積層コンデ ンサを例にして説明する。なお、本発明の効果を比較す るために、本発明に係る製造方法で製作したものを実施 例1とし、比較するために製作したものを比較例1、比 較例2として説明する。

【0009】本発明に係る積層コンデンサ10は、図1 に示すように、セラミックグリーンシートを積層してな る積層体11と、該グリーンシート上に印刷された内部 電極12.13と、該積層体11の両端部に設けた外部 電極14,15と、積層体11の外部電極形成面以外の 表面を被覆するガラスコート層16から構成されてい る。なお、積層コンデンサ10の製作方法は実施例1で 説明する。

【0010】本発明の効果を調べるために、まず、実施 例1として、以下の本発明に係る製造方法で積層コンデ 30 ンサ10を製作し、試料とした。

【0011】まず、BaCO3、CaCO3、TiO2を 原料として (Bao. so Cao. 20) 1. 005 Ti O3となるよ うに調合した。

【0012】次に、得られた粉体に純水を加えてジルコ ニアボールとともに5時間混合粉砕し、乾燥後、110 0℃で2時間仮焼した。この仮焼粉に、有機バインダ、 分散剤及び水を加えて、ジルコニアボールとともに数時 間混合した後、グリーンシートに形成した。

【0013】次に、そのグリーンシート上に、印刷法等 【課題を解決するための手段及び作用】前記目的を達成 40 の手法によりNiペーストを塗布し、内部電極を形成し た。その後、内部電極がグリーンシートを介して対向す るようにグリーンシートを積み重ね、さらに、保護用グ リーンシートを上下に配設して圧着し、一定の寸法に切 断し、H2ガスとN2ガスの混合ガス中で1300℃の還 元焼成をして、図1に示す内部電極12、13を有した 焼結積層体11を得た。その後、浸漬法等により焼結積 層体11の両端部に電極ペーストを付着させ、乾燥、焼 付けをして、外部電極14,15を形成した。

【0014】これを15wt%のケイ酸ナトリウム水溶

3

500℃で焼付けをして、ケイ素元素の含有量に対する アルカリ金属元素の含有量の原子比が0. 3以上のガラ スコート層16を施した。さらに、酸処理としてpH 4.0の硫酸水溶液中に1時間浸漬して、積層コンデン サ10を得た。

【0015】また、本発明の効果と比較するために、比 較例1として、実施例1において、pH4.0の硫酸水 溶液中に 1 時間浸漬する酸処理のみを省いて得た積層コ ンデンサを試料とした。

【0016】さらに、本発明の効果と比較するために、 比較例2として、実施例1において、15wt%のケイ 酸ナトリウム水溶液(Na/Si=0.6)に浸漬させ

る代わりに、アルカリ金属元素を含まないシリカゾルの 水溶液に浸漬させて得た積層コンデンサを試料とした。 【0017】以上の実施例1、比較例1及び比較例2で 得たそれぞれの積層コンデンサについて、絶縁抵抗の測 定を行うとともに、ガラスコート層の状態を走査型電子 顕微鏡 (SEM) により調べた。測定結果を表1に示 す。比較例1は、セラミック素体の絶縁抵抗の劣化が生 じた。比較例2は、ガラスコート層にひび割れが生じ た。

[0018] 10 【表1】

24.2			
	ケイ素元素の含有量に対するアル	ガラスコート	セラミック素体の絶
	カリ金属元素の含有量の濃度勾配	層のひび割れ	縁抵抗(Ω・c m)
実施例1	暫増有り	無し	1 0 1 2
比較例1	暫増無し	無し	1 0 8
比較例2	アルカリ金属元素無し	有り	1012

【0019】次に、図2に、実施例1と比較例1で得た それぞれの積層コンデンサをオージェ電子分光で測定 し、それぞれのガラスコート層のケイ素元素の含有量に 対するアルカリ金属元素の含有量の濃度勾配(Na/S i原子比)のデータを示す。実施例1では、Na/Si 原子比が表面近傍から内部に向かって暫増している。比 較例1では、表面近傍より内部側のNa/Si原子比は 一定である。

【0020】なお、ガラスコート層の表面から表面近傍 30 制することができる。 までの範囲は、いずれもNaの含有量が多いが、ガラス コート層の表面からの大気中の水分吸着及び二酸化炭素 吸着の影響でNaが表面に析出したものであり、本発明 において本質的な意味をもつものではない。また、実施 例1と比較例1で得たそれぞれの積層コンデンサの表面 近傍は、いずれもガラスコート層の表面から約0.02 μmの深さであった。

【0021】なお、本発明に係るチップ型電子部品及び その製造方法は、前記実施形態や実施例に限定されるも のではなく、その要旨の範囲内で種々に変更することが 40 12,13…内部電極 できる。特に、チップ型電子部品としては前記積層コン デンサ以外に、例えば、PTCサーミスタ、バリスタ、 フェライト等のチップ形のセラミック電子部品及びその

製造方法にも適用することができる。

[0022]

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明に よれば、セラミックからなる素体の表面に設けたガラス コート層がその表面近傍から内部に向かって、ケイ素元 素の含有量に対するアルカリ金属元素の含有量の原子比 が暫増しているため、ガラスコート層にひび割れが生じ にくく、セラミック素体の絶縁抵抗が劣化することを抑

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るチップ型電子部品の一実施形態を

【図2】実施例1と比較例1のケイ素元素の含有量に対 するアルカリ金属元素の含有量の原子比濃度勾配を示す グラフ。

【符号の説明】

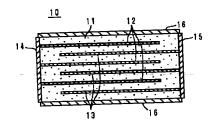
10…積層コンデンサ

11…積層体

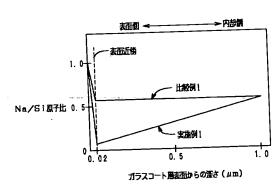
14, 15…外部電極

16…ガラスコート層





【図2】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷ 識別記号 H O 1 G 4/12 4 4 5 4 4 8

H01L 37/00

(72)発明者 新見 秀明

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内 FΙ

HO1G 4/12 448 HO1L 37/00 HO1G 1/02

Fターム(参考) 5E001 AB03 AC09 AE00 AE02 AE03

AF06 AG00 AH00 AH01 AH06

テーマコード(参考)

AH09 AJ04

PP03

5E082 AA01 AB03 BC19 BC35 BC40 EE04 EE23 EE35 FG06 FG26 FG27 FG54 GG10 GG28 HH26 HH43 JJ03 JJ23 LL02 LL03